

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
009135736 **Image available**
WPI Acc No: 1992-263174/199232
XRAM Acc No: C92-117379
XRPX Acc No: N92-201240

Thin-film semiconductor circuit prodn. for display panel – includes forming circuit on film-covered substrate bonding second substrate to circuit-formed face and etching covering film NoAbstract

Patent Assignee: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (NITE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 4178633	A	19920625	JP 90306269	A	19901114	199232 B

Priority Applications (No Type Date): JP 90306269 A 19901114

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	--------	----------	--------------

JP 4178633	A	6	G02F-001/136	
------------	---	---	--------------	--

Title Terms: THIN; FILM; SEMICONDUCTOR; CIRCUIT; PRODUCE; DISPLAY; PANEL; FORMING; CIRCUIT; FILM; COVER; SUBSTRATE; BOND; SECOND; SUBSTRATE; CIRCUIT; FORMING; FACE; ETCH; COVER; FILM; NOABSTRACT

Derwent Class: L03; P81; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/136

International Patent Class (Additional): H01L-027/12

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03813533 **Image available**

FORMATION OF SEMICONDUCTOR CIRCUIT

PUB. NO.: **04-178633** [JP 4178633 A]

PUBLISHED: June 25, 1992 (19920625)

INVENTOR(s): KATO KINYA

NAKAZAWA KENJI

SUYAMA SHIRO

TANAKA KEIJI

SAKAI SHIGENOBU

APPLICANT(s): NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> [000422] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 02-306269 [JP 90306269]

FILED: November 14, 1990 (19901114)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; H01L-027/12; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1436, Vol. 16, No. 495, Pg. 20, October 14, 1992 (19921014)

ABSTRACT

PURPOSE: To allow the transfer of circuits without using a costly polishing device by sticking a 1st substrate which is formed of the circuits with a 1st film or the 1st film and at least one layer of a 2nd film to a 2nd substrate on the side where the above-mentioned circuits are formed to each other, then etching away the 1st film and transferring the circuits onto the 2nd substrate.

CONSTITUTION: A molybdenum film is first deposited at the 1st film 12 on the 1st substrate 11 consisting of Si. An SiO(sub 2) film is then deposited as the 2nd film 13 thereon and thereafter, TFTs 17 formed by using a-Si as well as picture element electrodes 18 consisting of ITO (indium tin oxide) and wirings consisting of A1 are formed thereon to produce an active matrix 14. An adhesive 15 of, for example, an epoxy system is then applied on the matrix 14 and a PET film is stuck as the 2nd substrate 16 onto the circuits. The assembly is thereafter immersed into hydrogen peroxide and the molybdenum film 12 is completely removed by etching. Finally, the 1st substrate 11 is completely peeled and the above-mentioned circuits are completed.

⑩ 日本国特許庁 (JP) ⑪ 特許出願公開
 ⑫ 公開特許公報 (A) 平4-178633

⑤ Int. Cl.⁵
 G 02 F 1/136
 H 01 L 27/12

識別記号 500
 B

府内整理番号 9018-2K
 7514-4M
 9056-4M

⑬ 公開 平成4年(1992)6月25日
 H 01 L 29/78 311 A※
 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 半導体回路の形成方法

⑮ 特願 平2-306269
 ⑯ 出願 平2(1990)11月14日

⑰ 発明者 加藤 誠矢 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内
 ⑰ 発明者 中沢 憲二 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内
 ⑰ 発明者 陶山 史朗 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内
 ⑰ 発明者 田中 敬二 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内
 ⑰ 出願人 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号
 ⑰ 代理人 弁理士 中村 純之助

最終頁に統く

明細書

1. 発明の名称

半導体回路の形成方法

2. 特許請求の範囲

1. 第1の段、または第1の段および少なくとも1層の第2の段を介して回路を形成した第1の基板を上記回路を形成した側で第2の基板に張り合わせたのち、上記第1の段をエッチングにより除去することにより上記回路を上記第2の基板上に転写することを特徴とする半導体回路の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体回路の形成方法に係り、特に、基板の材質に制約のない半導体回路の形成方法に関する。

(従来の技術)

液晶ディスプレイ (LCD) に代表される印型で低消費電力の平面型表示装置 (ディスプレイ) の研究開発が盛んである。これらのディスプレイ

では、配線が形成された基板、または高表示品質を得るために、能動素子 (アモルファスSi薄膜トランジスタ [a-Si TFT] や多結晶Si薄膜トランジスタ [poly-Si TFT]) を作り込んだアクティブラチックス基板が必要であり、配線やアクティブラチックスが形成される基板材料にはガラスが用いられるのが一般的であった。しかし、ガラスではその耐熱温度に制約があり、上記配線や能動素子の製作に大きな制約を課していた。すなわち、安価なガラスの耐熱温度は極めて低く、また能動素子に悪影響を与えるアルカリ金属の含有が避けられない。このため、不純物含有が少なく、耐熱温度の高い安価なガラス基板の開発が要請されているが、これらの要求を満たすガラスの開発がままならない。一方、ガラス基板を用いるとその剛性のためディスプレイを未使用時に小さく折り畳んでおくことができない専用があった。したがって、未使用時には小さく折り畳むことができるフレキシブル基板を用いたディスプレイの出現が待望されている。

基板の制約を取り除く技術としては、1989年のインターナショナル エレクトロン デバイス ミーティング (International Electron Device Meeting (IEDM)) にデバイス伝導技術が報告されている (ケイ・スミヨシ(K. Sumiyoshi)他、「デバイス レイア トランジスタード ポリーサイコン ティーエフティー アレイ フォー ハイ レゾルーション リキッド クリスタル プロジェクター ("DEVICE LAYER TRANSFERED POLY-SI TFT ARRAY FOR HIGH RESOLUTION LIQUID CRYSTAL PROJECTOR")」, アイイーディーエム (IEDM)89, p.165, 1989)。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記の技術は Si 基板上に凹化膜 (SiO_x膜) を介してアクティブマトリクスを製作したのち、別の基板と張り合わせ、その後 Si 基板を研磨工程で除去するものである。研磨工程では Si より SiO_xの研磨速度が小さいため、SiO_xが現われたところで研磨を止めることができ、結果として Si 基板上に形成したデバイスを別の基板上に

転写することができる。上記報告では同じ工程を2回用い、まず別の Si 基板に転写したのち、次にガラス基板に転写している。これは、デバイスの天地反転を防止するためで本質ではない。この方法では、アクティブマトリクスを製作する基板として耐熱温度の高い Si 基板を用いることができるため、マトリクス製作における製作温度の制約が少なく、高温度で高活性の TFT の作製を可能にする利点があるが、研磨を用いて転写を行うため、剛性のないフレキシブル基板に転写しようとすると Si 基板が研磨により弱くなるに至るが、基板が変形し、研磨が均一にできないという根本的問題があった。さらに、コストの高い研磨装置を用意しなければならない問題があった。

本発明の目的は、上記問題を解決し、基板に対する剛性的ない回路の転写方法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、基板上に形成した回路と基板との間に介在させた膜をエッティングで除去する方法を用

いる。この膜のエッティング速度が大きく、製作した回路、デバイスや基板に対してこの膜を選択的に除去できれば回路、デバイスの転写が可能である。

すなわち、本発明の半導体回路の形成方法は、第1の膜、または第1の膜および少なくとも1枚の第2の膜を介して回路を形成した第1の基板を上記回路を形成した上で第2の基板に張り合わせたのち、上記第1の膜をエッティングにより除去することにより上記回路を上記第2の基板上に転写することを特徴とする。

〔作用〕

本発明では、回路を形成する基板に耐熱温度が高い基板や、回路に耐熱膜を与える特質を含まない基板を用いることができ、基板の制約を少なくすることができます。また、回路を転写するのに、従来技術のように研磨を行わなくて済むので、コストの高い研磨装置が不用であり、かつ剛性のないフレキシブル基板に転写しようとする場合も基板が変形する問題もない。

〔実施例〕

実施例 1

第1図 (a) ~ (f) は、本発明の半導体回路の形成方法の第1の実施例の工程断面図である。本実施例では、例えば4インチ径の Si の第1の基板上に回路としてアクティブマトリクスを形成し、ポリエチレンテレフタレート (PET) の第2の基板上に転写した例を示す。

まず、第1図 (a) に示すように、Si の第1の基板 1-1 上に第1の膜 1-2 としてモリブデン膜を約 1 μm 堆積する。次いで、(b) に示すように、製作工程中にモリブデン膜 1-2 が酸化性雰囲気に曝されないよう、第2の膜 1-3 として SiO_x 膜を堆積したのち、通常のアクティブマトリクス製作法で a-Si を用いた TFT 1-7 および ITO (酸化インジウム膜) の四端子部 1-8、A-1 の配線を形成し、アクティブマトリクス 1-4 を製作する。次いで、(c) に示すように、例えばエポキシ系の接着剤 1-5 をアクティブマトリクス 1-4 上に塗布し、(d) に示すように第2の基

板16としてPET膜を回路上に張り合わせる。その後、過酸化水素水中に没浸し、(e)に示すようにモリブデン膜12をエッティングする。このとき、エッティング速度を向上させるためエッティング液は加熱した。このようにしてエッティングを追行させてモリブデン膜12を完全に除去し、最後に(f)に示すように第1の基板11が完全に離れば完成する。

ここでモリブデンを第1の膜12に用いたのは酸化性雰囲気に弱く、過酸化水素への浸漬により容易にエッティング除去できること、過酸化水素水はSi、SiO₂、Al、ITO等アクティブマトリクス製作に用いた材料を全くエッティングしないため、きわめて高い選択エッティング性を有するためである。また、第2の膜13を設けたのは、モリブデン膜12がアクティブマトリクス製作時に酸化性雰囲気に直接曝されないようにするためにある。

こののち、この基板(第2の基板16)と対向回路を形成したPETからなる対向基板を高分子

分散型液晶を挿んで張り付け、ディスプレイを完成させた。このディスプレイを表示させたところ、ガラス基板上に形成したのと同等な表示特性が得られることを確認した。また、このディスプレイはフレキシブル性があり、適度な曲げには耐えられることが分かった。したがって、未使用時には小さく折り畳むことができるディスプレイを実現することができる。

実施例2

実施例1のモリブデン膜12の代わりにモリブデン膜形成時に酸素を含有したガスでスパッタしたモリブデン膜を用いた。このため、モリブデン膜は酸素を高濃度に含んでいる。酸素を高濃度に含むモリブデン膜はモリブデン膜より過酸化水素水でのエッティング速度が大きい。その後の工程は実施例1と同様とした。この結果、第1図(e)でのモリブデン膜の除去がきわめて高速度に行われる効果があった。特性等は全く同じであった。

実施例3

実施例1の膜1の膜12として、モリブデン膜

の代わりにCaF₂(弗化カルシウム)膜を用いた。この材料は単結晶Si基板上にニビタキシャル成長させることができ、さらにCaF₂上にSiをニビタキシャル成長させることができる。本実施例ではエビタキシャル成長させたSi膜をTFTの活性層として用いてアクティブマトリクスを作成した。第2の基板としてPET膜を張り合わせ、希釈エチアルコールでCaF₂を除去した。CaF₂は希釈エチアルコールで容易にエッティングでき、実施例1および2と同様にアクティブマトリクスを第2の基板に形成できた。本実施例では、第2の膜13(SiO₂膜)は形成しなかった。その後の工程は実施例1と同様にしてディスプレイを製作した。その結果、表示特性が得られることを確認した。

実施例4

第2図(a)は、本発明の第4の実施例を示す図、第2図(b)は、第2図(a)の裏部拡大断面図である。実施例1で述べた手法で多数のSi基板を第1の基板41としてその上にアクティブマトリクスを作成し、これらを第2図(a)に示

すようにPETの第2の基板42上に張り合わせた。その後、実施例1と同様にしてアクティブマトリクスを第2の基板上42に形成した。その後、第2図(b)に示すように、フォトプロセスによりスルーホール43を開口し、その後金属膜を堆積し、フォトプロセスを用いて各アクティブマトリクスを接続する金属配線44とした。この結果、個々のアクティブマトリクスを接続した大面积のアクティブマトリクスを完成できた。

こののち、この基板(第2の基板42)と対向回路を形成したPETからなる対向基板を高分子分散型液晶を挿んで張り付け、ディスプレイを完成させた。このディスプレイを表示させたところ、表示特性が得られることを確認した。

スルーホール43と配線44の形成は低温で行えるため、PET基板(42)のような耐熱温度の低い基板上でも問題なく行うことができた。また、配線の形成はスクリーン印刷でも可能であった。

このように、回路を分離して形成し、それらを

大面积基板上に形成することにより、容易に大面积基板上に大規模な回路を形成できる。この場合、分割された回路は大面积基板に取り合わせる前に個別の試験により選別でき、良品のみを形成することができるので、大規模回路の製造歩留まりを上げることができる。

実施例5

第3図は、本発明の第5の実施例を示す図である。実施例1で述べたのと同様な手法でSi基板を第1の基板51としてその上にシフトレジスタからなるアクティブマトリクスの駆動回路53をpoly-Si TFTで形成し、第3図に示すようにa-Si TFTを用いたアクティブマトリクス54を形成したガラスの第2の基板52に取り合せた。次いで、実施例1と同様に駆動回路を第2の基板52に形成した。その後、実施例4と同様な手法で駆動回路53とアクティブマトリクスを接続した。回路動作を試験したところ、駆動回路からの信号がアクティブマトリクス54に伝送されていることを確認した。実施例1と同様に

ディスプレイを完成させ、表示動作が確認できた。

実施例6

第4図は、本発明の第6の実施例を示す図である。実施例1で述べたのと同様な手法でSi基板を第1の基板としてその上にpoly-SiでnチャネルTFT61を形成し、同じく他のSi基板上にpチャネルTFT62を形成した。これらを第4図に示すようにガラスの第2の基板63に形成し、実施例4の方法で相補形MOS(CMOS)回路を構成するように接続した。この回路を試験したところ、CMOS動作することが確認できた。

このように、一連の工程で製作すると工程が複雑となるCMOS回路を、nチャネルとpチャネル部分に分離して形成し、形成して回路を構成することにより、工程が単純化できる。

以上説明したように、上記各実施例では、回路を形成する基板に耐熱温度が高い基板や、回路に耐熱性を与える物質を含まない基板を用いることができる、基板の制約を少なくすることができる。また、回路を形成するのに、従来技術のように研

磨を行わなくて済むので、コストの高い研磨装置が不用であり、低コスト化を達成でき、かつ耐性のないフレキシブル基板に形成しようとする場合も基板が変形する問題もない。

本発明の主旨は、容易にエッチング除去できる第1の膜を第1の基板上に形成し、その上に回路を形成したのち、第2の基板と取り合せたのち、第1の膜を除去することにより、回路を第2の基板上に形成することである。第2の膜は第1の膜が回路製作時に損傷を受けるのを防止するものである。したがって、本発明の主旨を逸脱しない限りにおいて組みの変更が可能なことは言うまでもなく、上記実施例において、例えば回路としてa-Si TFT、poly-Si TFTやエビタキシャル成長させたSi膜を用いたアクティブマトリクス、駆動回路を示したが、データパッファ回路等の回路であってもよい。口2の膜についてはSiO₂の他にSi₃N₄膜等を用いることができる。接着剤は用途によって選べばよく、何の制限もないことは明らかである。

【発明の効果】

以上に説明したように、本発明は高価な研磨装置を使用することなく回路を形成できるので、低コスト化が達成できる。また、回路を分離して形成し、それらを大面积基板上に形成することにより、容易に大規模回路を形成できる。このとき、分割された回路は個別の試験により選別でき、良品のみを形成することができるので、大規模回路の製造歩留まりを上げることができる。さらに、一連の工程で製作すると工程が複雑となるCMOS回路をnチャネルとpチャネル部分に分離して形成し、形成して回路を構成することにより、工程が単純化できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)～(f)は、本発明の半導体回路の形成方法の第1の実施例の工程断面図、第2図(a)は、本発明の第4の実施例を示す図、第2図(b)は、第2図(a)の局部拡大断面図、第3図は、本発明の第5の実施例を示す図、第4図は、本発明の第6の実施例を示す図である。

1 1、 4 1、 5 1、 6 2 … 第 1 の基板

1 2 … 第 1 の膜

1 3 … 第 2 の膜

1 4 … アクティブマトリクス

1 5 … 接着剤

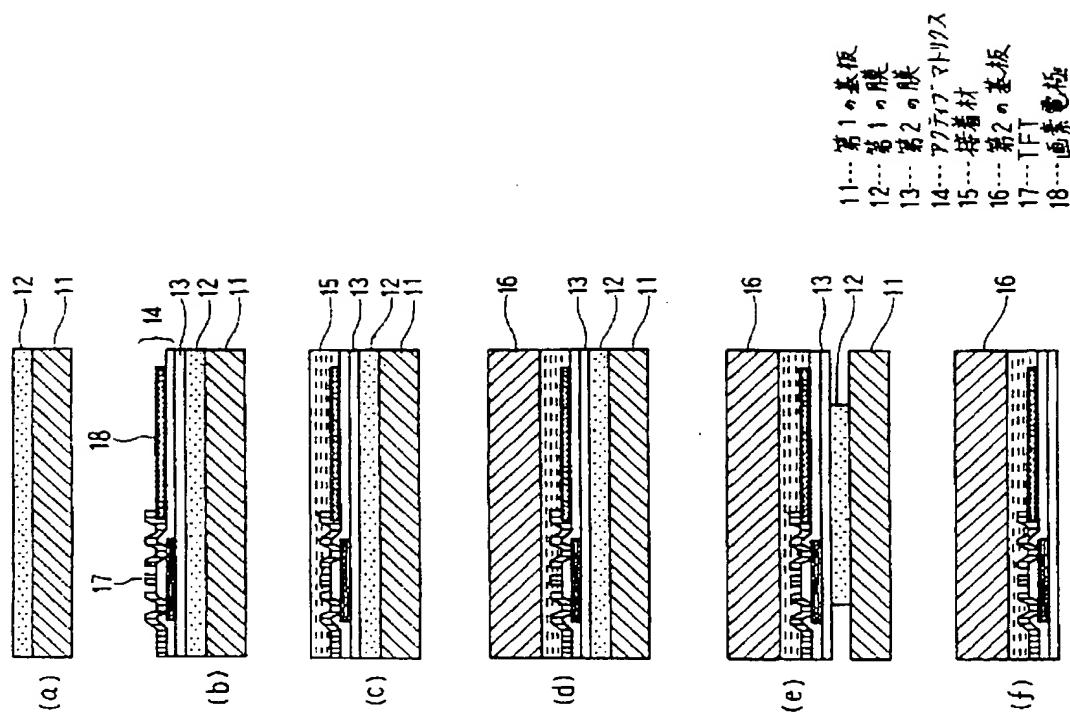
1 6、 4 2、 5 2、 6 3 … 第 2 の基板

6 1 … n チャネル TFT

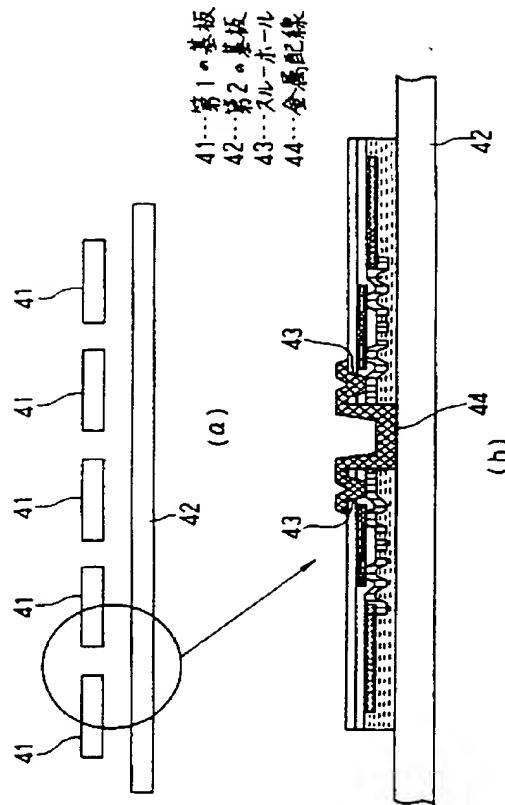
6 2 … p チャネル TFT

特許出願人 日本電信電話株式会社

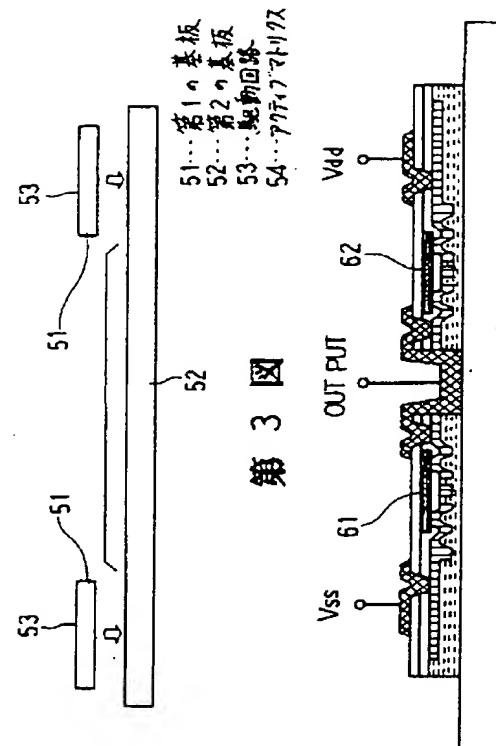
代理人弁理士 中村 純之助



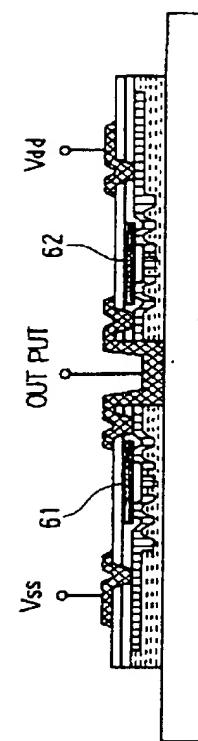
第 1 図



第2図



第3図



第4図

第1頁の続き

⑤Int. Cl.⁵
H 01 L 29/784

識別記号

庁内整理番号

⑥発明者 酒井 重信 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内